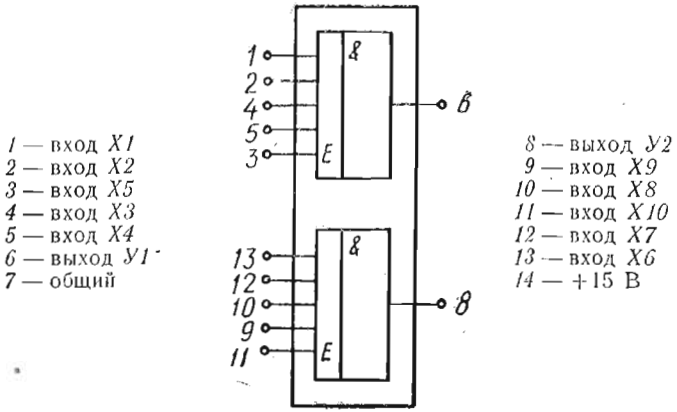
ДВА ЛОГИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТА «4И» С РАСШИРЕНИЕМ ПО «И» И ОТКРЫТЫМ КОЛЛЕКТОРНЫМ ВЫХОДОМ	К511ЛИ1

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА



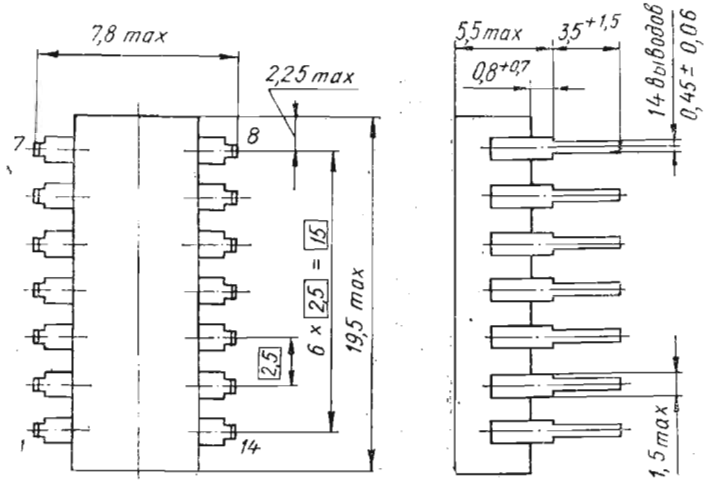
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

(при температуре 25±10°С)

Напряжение питания, В	15±10%
Ток потребления при высоком уровне выходного напряжения, мА, не более	9
Ток потребления при низком уровне выходного напряжения, мА, не более	12
Потребляемая мощность, мВт, не более	173
Входной ток высокого уровня, мА, не более	0,005
Входной ток низкого уровня по выводам, мА, не более:	
3, 11	1,33
1, 2, 4, 5, 9, 10, 12, 13	0,48
Выходной ток высокого уровня, мА, не более	0,1
Выходное напряжение низкого уровня, В, не более	1,5
Коэффициент разветвления по выходу	200
Время задержки, нс, не более:	
при включении	200
» выключении	250
Пороговое напряжение, В, не более:	
высокого уровня	8
низкого уровня	6

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ ОСТАЛЬНЫХ МИКРОСХЕМ

(корпус 201.14-9)



Масса не более 2,2 г

Смещение осей выводов от номинального расположения не более 0,1 мм (допуск зависимый).

Нумерация выводов микросхемы показана условно.

ВНЕШНИЕ ВОЗДЕЙСТВУЮЩИЕ ФАКТОРЫ

Синусоидальная вибрация:	
диапазон частот, Гц:	
К511ТВ1, К511ИЕ1, К511ИД1	от 1 до 2000
для остальных микросхем	от 1 до 500
амплитуда ускорения, м/с² (g):	
К511ТВ1, К511ИЕ1, К511ИД1	200 (20)
для остальных микросхем	100 (10)
Механический удар одиночного действия:	
пиковое ударное ускорение, м/с² (g)	1500 (150)
длительность действия ударного ускорения, мс	от 0,1 до 2,0

Механический удар многократного действия:	
пиковое ударное ускорение, м/с² (g)	
К511ТВ1, К511ИЕ1, К511ИД1	1500 (150)
для остальных микросхем	750 (75)
длительность действия ударного ускорения, мс	от 1 до 5
Линейное ускорение, м/с² (g):	
К511ТВ1, К511ИЕ1, К511ИД1	5000 (500)
для остальных микросхем	500 (50)
Пониженная рабочая температура среды, °С	минус 45
Повышенная рабочая температура среды, °С	70
Изменение температуры среды, °С	от минус 45 до +70

НАДЕЖНОСТЬ

Минимальная наработка *, ч:	
К511ТВ1, К511ИЕ1, К511ИД1	50 000
для остальных микросхем	25 000
Срок сохраняемости *, лет	15

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Микросхемы следует применять и эксплуатировать в соответствии с ГОСТ 18725—83 и требованиями, изложенными ниже.

При работе с микросхемами необходимо предусматривать защиту от воздействия статического электричества.

Допустимое значение статического потенциала не более 200 В.

Микросхемы пригодны для монтажа в аппаратуре методом групповой пайки и паяльником.

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ И РЕЖИМОВ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Напряжение питания, В:	
максимальное	16,5
минимальное	13,5
Входное напряжение, В:	
максимальное	20
минимальное	минус 0,5

* В условиях и режимах, допускаемых ОТУ или ТУ.

Максимальная емкость нагрузки, пФ:	
К511ТВ1, К511ИЕ1, К511ИД1	100
для остальных микросхем	680
Максимальный выходной ток высокого уровня, мА:	
К511ТВ1, К511ИЕ1	минус 0,2
К511ИД1	0,15
Максимальный выходной ток низкого уровня, мА:	
К511ТВ1, К511ИЕ1	12
К511ИД1	7